M-8

オゾンアニールを用いた PLD 法による AFeOx (A=Ca, Sr) 薄膜の作製 Prepared of AFeO_x (A=Ca, Sr) Thin Films by PLD method Using Ozone Annealing

○及川貴大¹, 土屋善人², 渡部雄太² 岩田展幸³, 山本寬³ *Takahiro Oikawa¹,Yoshito Tuchiya¹,Yuta Watabe² Nobuyuki Iwata³,Hiroshi Yamamoto³

Abstract: AFeOx(A-Ca,Sr) thin films were grown by Pulsed Laser Deposition (PLD) method using ozone annealing. Volume of CaFeOx (CFO) thin film unit cell was 0.057410[nm³]. And that of SrFeox(SFO) thin film unit cell was 0.058310[nm³]. Volume error between CFO pseudocubic and film unitcell was +6.87%. And that of SFO was +2.12%.

Although we used ozone has strong oxidizability, volume error still exist. Ozone is easily resolved by heat, so we will deposite at lower temperature to optimize temperature condiction to use ozone annealing.

1. 背景・目的

本研究の目的は,酸化物人工超格子を作製し,電界印加によって超格子界面での電荷移動を誘起させ,強磁性を発現させることである.これは巨大電気磁気効果と呼ばれている.

鉄系ペロブスカイト酸化物である BiFeO₃(BFO)及び AFeO₃(A=Ca,Sr)の超格子の,[Bi³⁺/O²]⁺¹/[Fe⁴⁺O₂⁴⁻]⁰界面は極性・無 極性を持つ界面になっている.この界面では AFeO₃(A=Ca,Sr)の Fe⁴⁺が不安定であることから,電荷の輸送により Kanamori-goodenough則に則った強磁性の発現が期待できる^{[1][2]}.しかし,AFOは鉄イオンの価数がFe⁴⁺よりもFe³⁺をとり やすく,ペロブスカイト構造が酸素欠損を起こしたブラウンミレライト構造を持つ AFO_{3-x} となってしまう.通常,AFeO₃ を PLD 法で成膜する際は超高酸素圧下での成膜が必要である.しかし、等酸素分圧 10¹⁸atom を持つオゾンを用いて焼 結体をアニールすることで,低圧下でも酸化物薄膜の酸素欠損量を減少させることが期待できる^[3].今回,オゾンアニー ルを用いた PLD 法による低圧下での CaFeOx(CFO),SrFeOx(SFO)薄膜を作製したので報告する.

2. 実験方法

2.1 基板洗浄

成膜に使用した基板には SrTiO₃(STO)を用いた.アセトン,エタ ノールによる超音波洗浄後,バッファードフッ酸(BHF:ph=5.0)に て酸洗処理を行った.その後,アニールを 920℃ で 6 時間行った. 洗浄条件を Table.1 に示す.

2.2PLD 法による成膜

CFO,SFO ともに,基板温度 670°C,20Pa の酸素雰囲気中で,KrF エキシマレーザー(λ= 248nm)をエネルギー密度 2.5J/cm²,周波数 4Hz で **CFO,SFO** ターゲットに 15 分間照射し成膜を行った.その 後,1kPaのオゾン雰囲気下,5°C /min で室温まで基板温度を降温さ せ,アニール処理を行った.成膜条件を Table.2 に示す。

3.	結果

3.1 CFO 薄膜

表面処理後の基板表面像と,CFO 成膜後の基板表面像をそれぞれ Fig.1(a)及び(b)に示す.(a)ではステップテラス構造が確認できるが,(b)では粒子の堆積が確認できた.

Table.2Condition for deposition Atmosphere O_2 Substrate temperature [$^{\circ}$ C] 670 4 Laser frequency[Hz] Laser energy density[J/cm²] 2.5 20 Pressure during deposition[Pa] Pressure during annealing[kPa] 1(ozone) Table.1 substrate treatment 5 Acethon[min] Acethon[min] 15 Ultrasonic Ethanol[min 5 Cleaning Deionized water[min] 30 BHF(pH:5.0)[s]60 Annealing 670 Tempareture[°C] Annealing time[h] 6

作製した CFO 薄膜の XRD20-0 パターンを Fig.2 に示す. 1.日大理工・学部・子情 2.日大理工・院(前) 3.日大理工・教員・子情 薄膜である CFO のピーク位置 θ とブラッグ条件より,算出した. 面直の格子定数の平均値は 0.7529[nm]となった. 面内の格子定 数いると仮定して 0.3509[nm]であるとする. これらの値から算 出した CFO 薄膜の単位格子の体積(Vunit)は 0.057410[nm³]となっ た. CaFeO₃ を疑似ペロブスカイト構造を持つ結晶として計算し たときの Vunit が 0.05372[nm³]であることから, CaFeO₃ と成膜し た CFO 薄膜の Vunit の誤差は+6.87%となった.

また, CFO が酸素欠損を起こして CaFeO_{2.5} となった際 に,CFO(002)と CFO(003)の間に現れるピークが見られないこと から,酸素欠損が減少していることがわかった.

3.2 SFO 薄膜

成膜前後の基板表面像を Fig.3(a),(b)にそれぞれ示す. CFO と同様 に,成膜前はステップテラス構造が確認できたが,SFO の成膜後 の基板には,CFO と同様に粒子が堆積していた.

作製した SFO 薄膜の XRD20-0 パターンを Fig.4 に示す. CFO と同様の計算方法から算出した面直方向の格子定数は 0.382439[nm]となった.また面直の格子定数も同様に STO の格子 定数である 0.3509[nm]であったと仮定すると,作製した CFO 薄膜 の Vunit は 0.058318[nm³]となる. 立方晶を持つ SrFeO₃の Vunit が 0.05711[nm³]であるので,誤差は+2.12%であることがわかった.

4. まとめ

オゾンアニールを用いた PLD 法により,低圧下での CFO,SFO 薄膜の作製を行った.

その後、薄膜の XRD20-0 測定結果から算出した格子定数をも とに、作製した薄膜の単位格子あたりの体積を計算し、CFO・SFO をそれぞれ疑似ペロブスカイト構造に直したときの単位格子あ たりの体積と比較した.その結果、CFO は+6.87%、SFO は+2.12% の誤差が生じた.この結果から、今回のオゾンアニールを含んだ 成膜方法では CaFeO₃及び SrTiO₃薄膜は、酸素欠損を含む CaFeO₃、 SrFeO₃、となることがわかった.しかし、CFO の XRD20-0 では酸 素欠損を示すピークが現れなかったためオゾンアニールによっ て、酸素欠損は減少していると考えられる.

5. 参考文献

[1]N.Iwata,Mater.Res.Soc.Symp.Proc.(2012) in press[2]J. Kanamori, J. Phys. Chem. Solids 10 (1959) 87.

[3]Naoaki Hayashi, Angew.chemi. **50**(2011) 12547



Fig.1 DFM images of CFO thin film (a)Before deposition (b)After deposition



Fig.2 XRD 2theta-theta pattern of CFO thin film



Fig.3 DFM images of SFO thin film (a)Before deposition (b)After Deposition



Fig.4 XRD 2theta-theta pattern of SFO thin film